



Title	極短紫外線縮小リソグラフィーのための斜め入射光による反射型マスクパターン転写特性に関する研究
Author(s)	菅原, 稔
Citation	大阪大学, 2005, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/45951
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名	菅 原 稔 ^{すが わら みのる}
博士の専攻分野の名称	博 士 (工 学)
学 位 記 番 号	第 1 9 5 6 6 号
学 位 授 与 年 月 日	平成 17 年 3 月 25 日
学 位 授 与 の 要 件	学位規則第 4 条第 1 項該当 基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名	極短紫外線縮小リソグラフィーのための斜め入射光による反射型マスク パターン転写特性に関する研究
論 文 審 査 委 員	(主査) 教 授 高 井 幹 夫 (副査) 教 授 岡 本 博 明 教 授 岡 村 康 行

論 文 内 容 の 要 旨

本論文は、極短紫外線縮小リソグラフィー (EUV (Extreme Ultra Violet) リソグラフィー) でハーフピッチ 22 nm 世代の LSI 製造のために、反射型マスク上に斜めに入射する露光光が転写特性に与える影響を理論的に考察し、ウェハ上転写像劣化の課題を把握し、かつ克服できることを明らかにした。また、反射型位相シフトマスクの設計および転写特性評価を行った。

第 1 章では、EUV リソグラフィーの概要を示し、本研究の目的と解決すべき課題を示した。

第 2 章では、配線パターン形成を想定し、反射型バイナリマスクを用いて転写特性を考察した。回折光強度の解析から斜め入射効果による光量損失の原因を定量的に明らかにし、光量損失を補償する方法を提唱した。回折光の振幅と位相の非対称性が転写性に与える影響を、ウェハ上光強度分布関数を導いて明確にした。投影光学系収差および吸収パターンの側壁角が転写性に与える影響を明らかにした。これら基礎的な考察から、新規に提唱した瞳通過光量補償法により、斜め入射効果と光近接効果によるウェハ上転写像の変形を、それぞれ独立に高速かつ高精度に補正し、良好なウェハ上転写像を得た。

第 3 章では、ゲートパターン形成を想定し、反射型マスク用の積層型位相シフトマスクについて考察した。位相シフト効果を得るために、材料の複素屈折率と膜厚の条件を容易に得るための設計方法を示した。Ta/Ru の 2 層構造ハーフトーン位相シフトマスク、および完全平坦な積層型渋谷ーレベンソン位相シフトマスクを設計した。これら位相シフトマスクで、線幅 18 nm のパターン転写が可能であることを明らかにした。メタルレス渋谷ーレベンソン位相シフトマスクで線幅 13 nm のパターン転写が可能であることを明らかにした。

第 4 章では、波長帯域幅を持つ露光光で、Mo/Si 反射多層膜の膜厚ばらつきの影響を受けることなく、適正焦点位置が得られることを明らかにした。

第 5 章では、本論文全体の研究成果を総括し、本論文で得られた主要な結論をまとめた。

論文審査の結果の要旨

半導体集積回路の超微細化、超高密度化に伴い、回路素子パターンを転写するリソグラフィー技術は DUV (Deep Ultraviolet) 縮小リソグラフィーから EUV (Extreme Ultraviolet : 極短紫外光) 縮小リソグラフィーに移行しようとしている。

本論文は、半導体技術ノード 22 nm 世代の極短紫外光縮小リソグラフィーを実用化する場合に問題となる斜め入射光を用いた反射マスクの転写特性を理論的に考察し、ウェハ上の転写像劣化の課題を明らかにし、反射型位相シフトマスクの設計指針および転写特性を明らかにしている。

配線パターン形成については、反射型バイナリマスクを用いて転写特性を考察している。ここでは、回折光強度の解析から斜め入射効果による光量損失の原因を定量的に明らかにし、光量損失を補償する方法を提唱している。次に回折光の振幅と位相の非対称性が転写性に与える影響を、ウェハ上光強度分布関数を導いて明確にしている。さらに、投影光学系収差および吸収パターンの側壁角が転写性に与える影響を明らかにしている。これらの基礎的な考察から、新規に提唱した瞳通過光量補償法により、斜め入射効果と光近接効果によるウェハ上転写像の変形を、それぞれ独立に高速かつ高精度に補正し、良好なウェハ上転写像を得ている。

ゲートパターン形成については、反射型マスク用の積層型位相シフトマスクについて考察しており、位相シフト効果を得るために、材料の複素屈折率と膜厚の条件を容易に得るための設計方法を示している。この方法を用いて、Ta/Ru の 2 層構造ハーフトーン位相シフトマスク、および完全平坦な積層型渋谷ーレベンソン位相シフトマスクを設計している。これらの位相シフトマスクで、線幅 18 nm のパターン転写が可能であることと、メタルレス渋谷ーレベンソン位相シフトマスクで線幅 13 nm のパターン転写が可能であることを明らかにしている。

さらに、波長帯域幅を持つ露光光で、Mo/Si 反射多層膜の膜厚ばらつきの影響を受けることなく、適正焦点位置が得られることを明らかにしている。

以上のように、本論文は極短紫外光縮小リソグラフィーの反射型マスクの問題点を解決し、マスク設計の指針を与えるものであり、半導体技術ノード 22 nm 世代の集積回路開発に大きく寄与するもので、博士 (工学) の学位論文として価値あるものと認める。